

シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ  
(PCT方式)(ダーリントン接続)

# 2SB1024

通信工業用

単位: mm

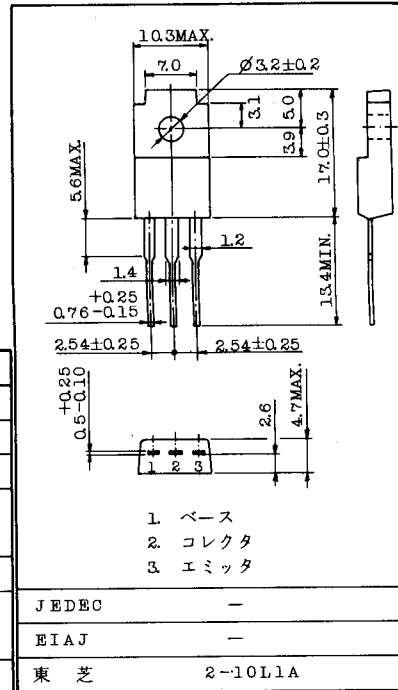
- スイッチング用
- ハンマードライブ用, パルスモータードライブ用
- 電力増幅用

特長

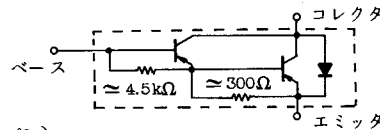
- ・ 直流電流増幅率が高い。  
:  $h_{FE} = 2000$  (最小) ( $V_{CE} = -2V, I_C = -1A$ )
- ・ 飽和電圧が低い。:  $V_{CE(sat)} = -1.5V$  (最大) ( $I_C = -3A$ )
- ・ 2SD1414とコンプリメンタリになります。

最大定格 ( $T_a = 25^\circ C$ )

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	-100	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	-80	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	-5	V
コレクタ電流	DC	$I_C$	-4
	パルス	$I_{CP}$	-6
ベース電流	$I_B$	-0.3	A
コレクタ損失	$T_a = 25^\circ C$	$P_C$	2.0
	$T_c = 25^\circ C$		2.0
接合温度	$T_j$	150	$^\circ C$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ 150	$^\circ C$



等価回路



電気的特性 ( $T_a = 25^\circ C$ )

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = -100V, I_E = 0$	-	-	-20	$\mu A$
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	-	-	-2.5	mA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -10mA, I_B = 0$	-80	-	-	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$	$V_{CE} = -2V, I_C = -1A$	2000	-	-	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -2V, I_C = -3A$	1000	-	-	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -3A, I_B = -6mA$	-	-	-1.5	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -3A, I_B = -6mA$	-	-	-2.0	V
スイッチング時間	ターンオン時間	$t_{on}$	-	0.15	-	$\mu s$
	蓄積時間	$t_{stg}$	-	0.80	-	
	下降時間	$t_f$	-	0.40	-	

